



电参数(除非特殊说明,  $T_C=25^\circ\text{C}$ )

参数	符号	测试条件	最小值	典型	最大值	单位
直流电流增益	HFE	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	10	-	-	-
		$V_{CE}=3\text{V}, I_C=800\text{mA}$	20	-	40	-
集电极、发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=1\text{A}, I_B=0.2\text{A}$	-	-	0.5	V
		$I_C=3.5\text{A}, I_B=1\text{A}$	-	-	1.5	V
基极、发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=3.5\text{A}, I_B=1\text{A}$	-	-	1.5	V
集电极、发射极漏电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=400\text{V}, I_B=0$	-	-	500	$\mu\text{A}$
集电极、基极漏电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=1050\text{V}, I_E=0$	-	-	100	$\mu\text{A}$
上升时间	$t_r$	$V_{CC}=250\text{V}, I_C=0.5\text{A}$ $I_{B1}=I_{B2}=100\text{mA}$	-	0.73	-	$\mu\text{s}$
存储时间	$t_s$		-	3.5	-	$\mu\text{s}$
下降时间	$t_f$		-	1.02	-	$\mu\text{s}$

典型特性曲线

图1. 典型电压&电流曲线( $T_C=25^\circ\text{C}$ )

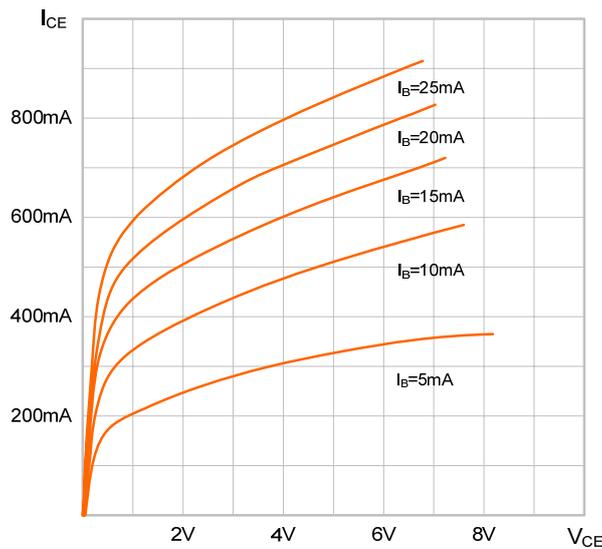
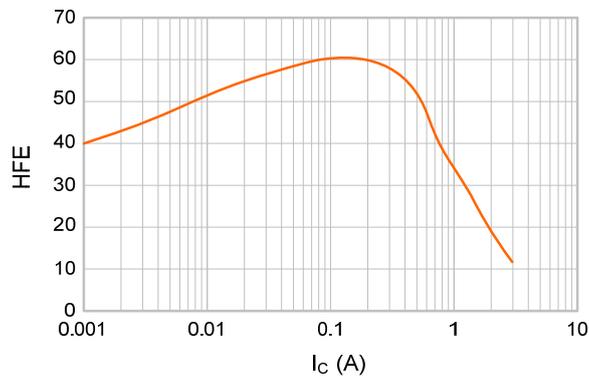
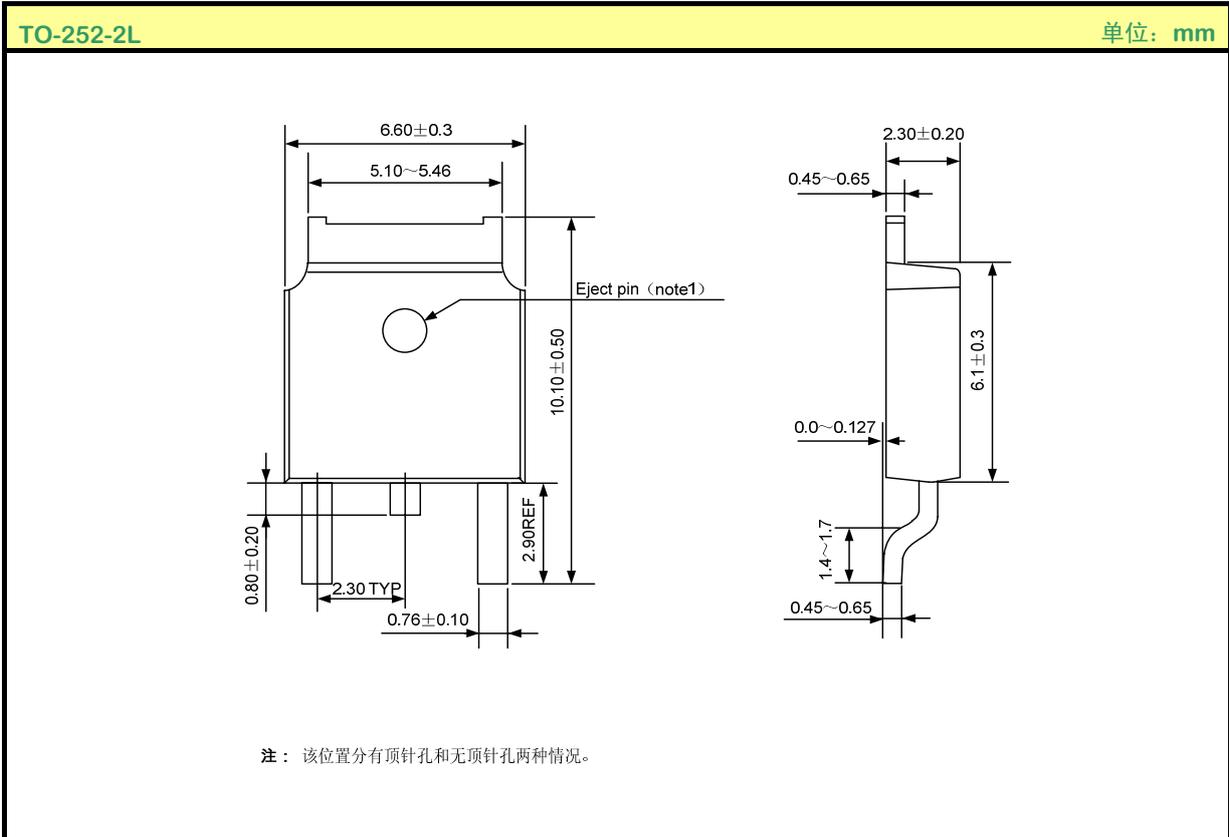


图2. 典型电流增益&电流关系曲线( $T_C=25^\circ\text{C}$ )



封装外形图



声明:

- 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

附：

修改记录：

日期	版本号	描 述	页 码
2010.12.07	1.0	原版	
2011.07.07	1.1	修改“封装外形图”	3